

	<p>SI4835DDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4835DDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 13A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4835DDY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 69790 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4835DDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 13A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	69790 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5.6W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4835DDY-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1960pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 13A (Tc) 2.5W (Ta), 5.6W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)

SI4835DDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4835DDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4835DDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4835DDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4835DDY-TI-E3 VISHAY VISAHY SOP-8</p>	 <p>SI4835DDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 13A 8-SOIC</p>	 <p>SI4835DDY VISHAY SI4835DDY VISHAY</p>	 <p>SI4835DDY-TI-GE3 VISHAY VISHAY SOP8</p>
 <p>SI4835DY VISHAY SI4835DY VISHAY</p>	 <p>SI4835DDY-T1-E3. VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4835DDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 13A 8-SOIC</p>	 <p>SI4835DDY-T1 VISHAY SI4835DDY-T1 VISHAY</p>

SI4835DDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4835DDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4835DDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4835DDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4835DDY-T1-GE3 Electronic	SI4835DDY-T1-GE3	SI4835DDY-T1-GE3-Komponenten	SI4835DDY-T1-GE3-Verteiler	SI4835DDY-T1-GE3-Bild	SI4835DDY-T1-GE3
SI4835DDY-T1-GE3 Preis	SI4835DDY-T1-GE3	SI4835DDY-T1-GE3 Hersteller	SI4835DDY-T1-GE3-Bild	SI4835DDY-T1-GE3 Aktie	SI4835DDY-T1-GE3-Teil
SI4835DDY-T1-GE3 Neu	SI4835DDY-T1-GE3	SI4835DDY-T1-GE3 Original	SI4835DDY-T1-GE3 garantiert	SI4835DDY-T1-GE3 RFQ	SI4835DDY-T1-GE3 Inventar
					SI4835DDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited